# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Волим 3.0. Ф.И.О.

2018г.

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Фотоэлектрические явления в полупроводниках

(наименование дисциплины)

#### Основной профессиональной образовательной программы

#### магистратуры

(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры)

03.04.02 «Физика»

(код и наименование направления подготовки/специальности)

#### «Физика полупроводников»

(наименование профиля подготовки (при наличии))

#### Квалификация выпускника

магистр

#### Форма обучения

очная

(очная, заочная)

МАГАС, 2018 г.

Составители рабочей программы Доцент каф.общей физики, к.фм.н. Нальгиева М. А. / <i>Миши</i> /
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры общей физики
Протокол заседания № <u>8</u> от « <u>23</u> » <u>апрыя</u> 2018 г.
Заведующий кафедрой/ Торшхоева З. С./
Рабочая программа одобрена учебно-методическим советом физико-математического факультета.
- 4 4 4 200
Протокол заседания № <u>4</u> от « <u>4</u> » <i>Шал</i>
Председатель учебно-методического совета  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета
протокол № <u>9</u> от « <u>23</u> » <u>Ilal</u> 20 <u>/</u> 8 г.
Председатель Учебно-методического совета университе в Монесов / Монесов / Монесов / Ф. И. О.)

#### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Фотоэлектрические явления в полупроводниках» относится к дисциплинам магистерской подготовки, формирующим современную точку зрения на приоритетные направления развития, в частности, электроники и средства реализации идей микро- и наноэлектроники. Данная дисциплина изучается во 2-м семестре.

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.

К задачам изучения дисциплины относится получение знаний по основным направлениям развития электроники и наноэлектроники, умений применять данные знания для создания новых твердотельных, в том числе низкоразмерных сред при производстве электронных устройств нового поколения, овладение методами экспериментального исследования, сведениями о современных технологиях изготовления устройств наноэлектроники.

#### 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.4

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина «Фотоэлектрические явления в полупроводниках» является логическим продолжением таких дисциплин, как «Физика полупроводников» и «Физика полупроводниковых приборов», которые изучаются на 1-ом и 2-ом курсах. Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями о фотопроводимости, подвижности, концентрации основных и неосновных носителей заряда, о полупроводниковых приборах и т.д. Знания, полученные по данной дисциплине, применяются на преддипломной практике на 2-ом курсе 4-го семестра и при написании и защиты выпускной квалификационной работы.

Таблица 2.1. Связь дисциплины «Фотоэлектрические явления в полупроводниках» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения

	Дисциплины, предшествующие дисциплине «Фото- электрические явления в полупроводниках»	Семестр
Б1.В.ОД.6	Современные проблемы физики	1
Б1.В.ОД.1	Современные проблемы науки и производства	1, 2
Б1.В.ДВ.5	Физика полупроводников	1, 2

Таблица 2.2. Связь дисциплины «Фотоэлектрические явления в полупроводниках» с последующими дисциплинами и сроки их изучения

Код дисциплины	Дисциплины, следующие за дисциплиной «Фото- электрические явления в полупроводниках»	Семестр
Б2.П.2	Практика по закр. проф. умений и навыков	4
Б2.П.4	Преддипломная практика	4

Таблица 2.3. Связь дисциплины «Фотоэлектрические явления в полупроводниках» со смежными дисциплинами

Код дисципли-	Дисциплины, смежные с дисциплиной «Фотоэлектриче-	Семестр
ны	ские явления в полупроводниках»	
Б.1.Б.2	Специальный физический практикум	3
Б1.В.ДВ.2	Физика полупроводниковых приборов	3

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженернотехнологической деятельности (ПК-3);

способностью планировать и организовывать физические исследования, научные семинары и конференции (ПК-4);

Таблица 3.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень компетенций, которыми	Степень реали- зации компе-	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)			
должны овладеть	тенции при изу-	Знания	Умения	Владения	
обучающиеся в ре-	чении дисци-			(навыки)	
зультате освоения	плины (модуля)				
образовательной					
программы					
профессиональные ком	ипетенции				
ПК-3	полностью	Знать ключевые разделы физики на основании которых проводится разработка новых методов и методических подходов, а так же принципы верификации разрабатываемых методов	Уметь при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи	Владеть навыками разработки новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженернотехнологической деятельности	
ПК-4	полностью	Знать основные методы планирования и организации физических исследований, в	Уметь выделять и систематизировать основные результаты эксперимен-	Владеть навыками критического ана- лиза и (оценки со- временных научных	

	том числе - междис-	тальных / теорети-	достижений и (ре-
	циплинарного харак-	ческих исследова-	зультатов деятель-
	тера	ний и корректиро-	ности по (решению
		вать план дальней-	исследовательских
		ших научных работ	(и практических
		с учетом получен-	задач, в том (числе в
		ных результатов	междисциплинарных
			(областях

Таблица 3.2. Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций

Этап (уро-	Планируемые ре-	Критерии оценивания результатов обучения				
вень) освое- ния компе-	зультаты обучения (показатели достиже-	2	3	4	5	
Первый этап (базовый, по- роговый) (ПК- 3)	Знать ключевые разделы физики конденсированного состояния и физического материаловедения, на основании которых проводится разработка новых методов и методических подходов	Фрагментарные знания ключевых разделов физики конденсированного состояния и физического материаловедения, на основании которых проводится разработка новых методов и методических подходов	лы) знание ключевых разделов физики конденсированного состояния и физического материаловедения, на основании которых проводится разработка	Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, знаниеключевых разделов физики конденсированного состояния и физического материаловедения, на основании которых проводится разработка новых методов и методических подходов	Полностью сформированное и системное знание ключевых разделов физики конденсированного состояния и физического материаловедения, на основании которых проводится разработка новых методов и методических подходов	
	Знать принципы разработки новых методов (методик) исследований структуры и свойств материалов	Фрагментарные знания принципов разработки новых методов (методик) исследований структуры и свойств материалов	Неполное (содержащее существенные пробелы) знание принципов разработки новых методов (методик) исследований структуры и свойств материалов	Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, знаниепринципов разработки новых методов (методик) исследований структуры и свойств материалов	Полностью сформированное и системное знание принципов разработки новых методов (методик) исследований структуры и свойств материалов	
	Знать принципы верификации разрабатываемых методов (методик)	Фрагментарные знания принципов верификации разрабатываемых методов (методик)	Неполное (содержащее существенные пробелы) знание принципов верификации разрабатываемых методов (методик)	Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, знаниепринципов верификации разрабатываемых методов (методик)	Полностью сформированное и системное знание принципов верификации разрабатываемых методов (методик)	
	Уметь при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи	Частично освоенное умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи	В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение при решении исследо- вательских и практиче- ских задач генерировать идеи	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи	Сформированное умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи	
	Владеть навыками разработки новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической деятельности	Фрагментарное применение навыков разработки новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно технологической деятельности	В целом успешное, но не систематическое применение навыков разработки новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженернотехнологической деятельности	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков разработки новых методов и методических подходов в научноинновационных исследованиях и инженерно- технологической деятельности	Успешное и систематическое применение навыков разработки новых методов и методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно- технологической деятельности	
	* *		В целом успешное, но не систематическое применение навыков планирования научно-исследовательских работ при разработке новых методов и подходов	содержащее отдельные пробелы применение навыков планирования научно- исследовательских работ при разработке	навыков планирования	

Этап (уровень) освоения компе-	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения					
тенции*	компетенций)	2	3	4	5	
Первый этап (базовый, пороговый) (ПК-4)	Знать основные методы планирования и организации физических исследований, в том числе - междисциплинарного характера	Фрагментарные знания основных методов планирования и организации физических исследований, в том числе — междисциплинарного характера	Неполное (содержа- щее существенные пробелы) знание основных методов планирования и ор- ганизации физиче- ских исследований, в том числе — междис- циплинарного харак- тера	Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, знание-основных методов планирования и организации физических исследований, в том числе - Междисциплинарного характера	Полностью сформированное и системное знание основных методов планирования и организации физических исследований, в том числемждисциплинарного характера	
	Знать основные этапы (правила) организации и работы научных семинаров и конференций	Фрагментарные зна- ния основных этапов (правил) организации и работы научных семинаров и конфе- ренций	основных этапов (правил) организации и работы научных семинаров и конфе- ренций	Сформированное, но содержащее отдельные пробелы, знание-основных этапов (правил) организации и работы научных семинаров и конференций	Полностью сформированное и системное знание основных этапов (правил) организации и работы научных семинаров и конференций	
	Уметь выделять и систематизи- ровать основные результаты экспериментальных / теорети- ческих исследований и коррек- тировать план дальнейших научных работ с учетом полу- ченных результатов	Частично освоенное умение выделять и систематизировать основные результаты экспериментальных / теоретических исследований и корректировать план дальнейших научных работ с учетом полученных результатов	экспериментальных / теоретических ис-	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение выделять и систематизировать основные результаты экспериментальных / теоретических исследований и корректировать план дальнейших научных работ с учетом полученных результатов	Полностью сформированное умение выделять и систематизировать основные результаты экспериментальных / теоретических исследований и корректировать план дальнейших научных работ с учетом полученных результатов	
	Уметь использовать технологии планирования сложных научных исследований, в том числемеждисциплинарного характера	Частично освоенное умение использовать технологии планирования сложных научных исследований, в том числе — междисциплинарного характера	В целом успешное, но не системное уме- ние использовать технологии планиро- вания сложных науч- ных исследований, в том числе — междис- циплинарного харак- тера	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение использовать технологии планирования сложных научных исследований, в том числе — междисциплинарного характера	рованное умение использовать техно-логии планирования сложных научных исследований, в том числе междисциплинарного характера	
	тива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических исследований	умение самостоятельно и в составе научнопроизводственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических исследований	не системное умение самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических исследований	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение самостоятельно и в составе научнопроизводственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических исследований	рованное умение самостоятельно и в составе научно- про- изводственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических исследований	
	Уметь организовывать научные семинары и конференции	Частично освоенное умение организовы- вать научные семина- ры и конференции	не системное умение	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение организовывать научные семинары и конференции	рованное умение организовывать научные семинары и конференции	
	Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Фрагментарное применение навыков критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	не систематическое применение навыков критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследова-	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Успешное и систематическое применение навыков критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	

Владеть навыками коммуника-	Фрагментарное при-	В целом успешное,	В целом успешное, но	Успешное и система-
ции с ведущими учеными в	менение навыков	но не систематиче-	содержащее отдель-	тическое применение
режиме «научной конферен-	коммуникации с ве-	ское применение	ные пробелы приме-	навыков коммуника-
ции» или «научного семинара»	дущими учеными в	навыков коммуника-	нение навыков ком-	ции с ведущими уче-
	режиме «научной	ции с ведущими уче-	муникации с ведущи-	ными в режиме
	конференции» или	ными в режиме	ми учеными в режиме	«научной конферен-
	«научного семинара»	«научной конферен-	«научной конферен-	ции» или «научного
		ции» или «научного	ции» или «научного	семинара»
		семинара»	семинара»	
Владеть навыками организаци-	Фрагментарное при-	В целом успешное,	В целом успешное, но	Успешное и система-
онной деятельности (в части	менение навыков	но не систематиче-	содержащее отдель-	тическое применение
организации научных семина-	организационной	ское применение	ные пробелы приме-	навыков организаци-
ров для небольших научных	деятельности (в ча-	навыков организаци-	нение навыков орга-	онной деятельности
групп)	сти организации	онной деятельности	низационной дея-	(в части организации
	научных семинаров	(в части организации	тельности (в части	научных семинаров
	для небольших науч-	научных семинаров	организации научных	для небольших науч-
	ных групп)	для небольших науч-	семинаров для не-	ных групп)
		ных групп)	больших научных	
			групп)	

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

#### Структура и содержание дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего ча-
	сов
Общая трудоемкость	144
Аудиторные занятия	38
Лекции	18
Практические занятия	18
Лабораторные занятия	
Контроль самостоятельной работы	2
Самостоятельная работа	52
Промежуточная форма контроля -	
Итоговая форма контроля - Э	54
Зачетные единицы	4

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Таблица 5.1.

## Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий (общая трудоемкость учебной дисциплины — 4 зачетных единиц)

Раздел, тема программы	Трудоемкость (час)				
учебной дисциплины	Всего	В том числ	е по видам учебнь	их занятий	
		Лекции	Семинары, практические занятия	Лабораторные ра- боты	
Раздел 1. ФОТОПРОВОДИМОСТЬ	24	12 12			
Тема 1 ФОТОАКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ И	6	3		3	

ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ			
Тема 2	6	3	3
ФОТОПРОВОДИМОСТЬ.			
ДВИЖЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ			
ЗАРЯДА В			
ФОТОПРОВОДНИКАХ			_
Тема 3 РЕКОМБИНАЦИЯ В	6	3	3
ФОТОПРОВОДНИКАХ			
Тема 4 ФОТОПРОВОДИМОСТЬ	6	3	3
НЕОДНОРОДНЫХ			
ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ			
Раздел 2	10		
Раздел 2 ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	12	6	6
И ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ			
Тема 1 ВИДЫ	4	2	2
ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	4	2	2
ЭФФЕКТА			
Тема 2	4	2	2
ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ	•	_	2
ЭФФЕКТ. ФОТОДИОД			
Тема 3 СПЕКТРАЛЬНАЯ	4	2	2
ХАРАКТЕРИСТИКА			
ФОТОПРОВОДИМОСТИ			
Итого аудиторных часов	36	18	18
Самостоятельная работа	2		
студента, в том числе:			
- в аудитории под контро-			
лем преподавателя			
- внеаудиторная работа			
Экзамен	54		
Всего часов на освоение	144		
учебного материала			
1		1	

#### 5.2 Содержание модулей курса

#### Тема 1 ФОТОПРОВОДИМОСТЬ

Для изучения данной темы обучающийся должен:

#### Знать:

- -основные физические явления, определяющие концентрацию и энергетический спектр носителей заряда в твердом теле;
- -физические механизмы переноса и рассеяния носителей заряда в полупроводниках;

#### Уметь:

- -проводить оценки основных параметров, характеризующих физические процессы в полупроводниках и полупроводниковых устройствах;
- -пользоваться монографической, а также периодической научно-технической литературой по физике полупроводников и полупроводниковым приборам;
- -использовать современные информационные и компьютерные технологии для оценки количественных и качественных показателей состояния поверхности твердого тела и прогноза характеристик твердого тела;
- приобретать навыки работы в творческом коллективе;
- отстаивать публично свою точку зрения;
- готовить материалы к докладам и публикациям.

#### Содержание темы:

1. ФОТОАКТИВНОЕ ПОГЛОШЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ

- Первичные и вторичные фототоки
- 2. ФОТОПРОВОДИМОСТЬ. ДВИЖЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ФОТОПРОВОДНИКАХ
- Примеры простых фотопроводящих систем
- Диффузия и дрейф фотоносителей в монополярном полупроводнике
- Эффективное время установления диффузионно-дрейфового
- О длине экранирования в плохо проводящих полупроводниках и диэлектриках
- Распределение концентрации при наличии внешнего электрического поля
- О классификации фототоков в однородных полупроводниках
- Особенности диффузии и дрейфа фотоносителей в биполярном полупроводнике
- Добротность фотопроводников
- 3. РЕКОМБИНАЦИЯ В ФОТОПРОВОДНИКАХ
- Рекомбинационная модель Шокли-Рида
- Фотопроводник с одним классом центров рекомбинации в условиях различной освещенности
- Прилипание носителей заряда
- Два класса центров рекомбинации
- Очувствление фотопроводников при освещении
- Отрицательная фотопроводимость
- 4. ФОТОПРОВОДИМОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ
- Фотопроводимость поликристаллических веществ
- Фотопроводимость, ограниченная контактами
- Фотоэлектрические свойства контакта металл монополярный полупроводник (диэлектрик)
- Стационарные характеристики монополярного фоторезистора при контактном ограничении
- Фотопроводимость при экситонном поглощении
- Остаточная проводимость
- Униполярная отрицательная фотопроводимость.
- Аномальная фотопроводимость
- Долговременные релаксации в фотопроводниках

#### Тема2. ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ

Для изучения данной темы обучающийся должен:

#### Знать:

- -основные физические явления, определяющие концентрацию и энергетический спектр носителей заряда в твердом теле;
- -физические процессы в полупроводниковых приборах, являющихся элементами микросхем.

#### Уметь:

- -рассчитывать статические и динамические характеристики полупроводниковых устройств на основе данных, определяющих физические параметры материалов и конструкцию устройства;
- -пользоваться монографической, а также периодической научно-технической литературой по физике полупроводников и полупроводниковым приборам;
- -оценивать области применимости полупроводниковых приборов.
- приобретать навыки работы в творческом коллективе;
- отстаивать публично свою точку зрения;
- готовить материалы к докладам и публикациям.

#### Содержание темы:

- 1. ВИДЫ ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
- Формирование представлений

- Метод эквивалентных схем
- Фотоиндуктивный эффект
- Остаточная фотоемкость
- О прохождении переменного тока в неоднородных кристаллах с подвижной объемной неоднородностью
- Применение к биполярному транзистору
- О классификации различных проявлений ФДЭ
- Применение фотодиэлектрического эффекта
- Фотоварикапы
- Динамический фотоконденсатор
- 2. ПОНЯТИЕ О ШУМАХ ФОТОПРОВОДНИКОВ
- 3. ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. ФОТОДИОД
- 4. СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОПРОВОДИМОСТИ

#### 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 6.1. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине

№п.п.	Тема программы дисциплины	Применяемые технологии	Кол-во аудит. часов
1	ФОТОАКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ	классическое традиционное; лекционное обучение	6
2	ФОТОПРОВОДИМОСТЬ. ДВИЖЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ФОТОПРОВОДНИКАХ	классическое традиционное; лекционное обучение, наглядные, программированные	6
3	РЕКОМБИНАЦИЯ В ФОТОПРОВОДНИКАХ	классическое традиционное; лекционное обучение, вербальные (аудио)	6
4	ФОТОПРОВОДИМОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ	классическое традиционное; лекционное обучение, самостоятельная работа	6
5	ВИДЫ ФОТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА	классическое традиционное; лекционное обучение, самообучение	4
6	ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. ФОТОДИОД	классическое традиционное; лекционное обучение, дистанционные	4
7	СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОПРОВОДИМОСТИ	классическое традиционное; лекционное обучение, компьютерное программированное обучение	4

### 7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

**Целью** самостоятельной работы магистранта является самостоятельное приобретение новые знаний и выработка способности к постоянному самообучению и самосовершенствованию в профессиональной и социально-общественных сферах деятельности.

Самостоятельная учебная работа представлена такими формами учебного процесса, как лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, экскурсии, подготовка к ним. Студент должен уметь вести краткие записи лекций, составлять конспекты, планы и тезисы выступлений, подбирать литературу и т.д.

Научная самостоятельная работа студента заключается в его участии в работе кружков на кафедрах, в научных конференциях разного уровня, а также в написании контрольных, курсовых и выпускных квалификационных (дипломных работ) работ.

Таблица 7.1. Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы

Ты	
1. Основные параметры фотопроводимости: время ее нарастания и спада, стационарное время фотопроводимости.  2 Эффект прилипания носителей, влияние его на параметры примесной фотопроводимости.  3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  5 Стационарное распредетельних тем, парагорные занаправлении распространения света в полупроводнике  6 коллок коллок коллок коллок конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, дополнительной литературы, и конспектирование зание рекомендованной литературы;  6 коллок конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, и конспектирование зание рекомендованной литературы;  6 стационарное распредение отдельных тем, парагорные зание отдельных тем, парагор	контроля
1. Основные параметры фотопроводимости: время ее нарастания и спада, стационарная величина и стационарное время фотопроводимости.  2. Эффект прилипания носителей, влияние его на параметры примесной фотопроводимости.  3. Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4. Обнаружительная способность ИК приемнинков и их зависимости от параметров полупроводиков  5. Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  5. Стационарное распределение отделения света в полупроводнике  5. Стационарное распределение отделения света в полупроводнике  6. Стационарное распределения света в полупроводнике  7. Стационарное распределения света в полупроводнике  8. Направлении распростамини по сложения выполновной пработа над конспектом декции; дабораторные завыполновных тем, паралеговных тем, па	ятельнои
фотопроводимости: время ее нарастания и спада, стационарная величина и стационарное время фотопроводимости.  2 Эффект прилипания носителей, влияние его на параметры примесной фотопроводимости.  3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  5 Стационарное распредетеление неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  5 Марка Выполновных тем, парагработа над конспектом декции; лабораторные завиосимости от параметров полупроводнике консультации по сложным, непонятным вопросам лекций	
мя ее нарастания и спада, стационарная величина и стационарное время фотопроводимости.  2	ение лабо-
стационарная величина и стационарное время фотопроводимости.  2	ах работ
стационарное время фотопроводимости.  2	
топроводимости.  2 Эффект прилипания но- сителей, влияние его на параметры примесной фотопроводимости.  3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная спо- собность ИК приемни- ков и их зависимости от параметров полупро- водников  5 Стационарное распреде- ление неравновесной концентрации носителей в направлении распро- странения света в по- лупроводнике  Коллоквиум; доработка конспекта лекции с при- менением учебника, мето- дической литературы, до- полнительной литературы, и конспектирова- ние рекомендованной ли- тературы;  Выполн работа над конспектом лекции; лабораторные за- не отдельных тем, пара- графов  Выполн работа над конспектом лекции; лабораторные за- не отдельных тем, пара- графов консультации по слож- ным, непонятным вопро- сам лекций	
<ul> <li>2 Эффект прилипания носителей, влияние его на параметры примесной фотопроводимости.</li> <li>3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости</li> <li>4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников</li> <li>5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике</li> <li>5 Стационарное распределение неравновесной консцентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике</li> <li>6 Оффект прилипания конспекта декции с примение параметров полупроводников</li> <li>7 Основные механизмы менением учебника, методической литературы, дополнитературы, д</li></ul>	
сителей, влияние его на параметры примесной менением учебника, метофотопроводимости.  З Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемникаюв и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распредераюванием неравновесной лекции; лабораторные зание отдельных тем, параграфов  5 Стационарное распредераюванием над конспектом параметрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  консультации с применением учебника, метофической литературы, дополнительной литературы, иконспектом раторные зание отдельных тем, параграфов  консультации по сложеным, непонятным вопростам лекций	
параметры примесной фотопроводимости.  3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  1	зиум
фотопроводимости. дической литературы, дополнительной литературы  3 Основные механизмы рекомбинации носителей и конспектирование рекомендованной литературы;  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников полупроводников и их зависимости от параметров полупроводников полупроводников и их зависимости от параметров полупроводников полупро	
Полнительной литературы  3 Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  1 подбор, изучение, анализ и конспектирование конспектом работа над конспектом собность ИК приемников полупроводников полупроводников полупроводников полупроводнике подборждение, анализ и конспектом раторные завыполновных тем, параграфов полупроводнике подборждение, анализ и конспектом раторные завыполновных тем, параграфов полупроводнике подборждение, анализ и конспектом раторные завыполновным работа над конспектом раторные завыполновным раторным	
Основные механизмы рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости      Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников      Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распроступроводнике      Основные механизмы подбор, изучение, анализ и конспектирование детом декции; лаборанной литературы;      обнаружительная споработа над конспектом декции; лабораторные заграфов      Стационарное распредеработа над конспектом декции; лабораторные заграфов      странения света в порупроводнике      оборудованием; консультации по сложеным, непонятным вопросам лекций	
рекомбинации носителей и конспектирова- заряда и температурная ние рекомендованной ли- зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная спо- собность ИК приемни- ков и их зависимости от параметров полупро- водников ние отдельных тем, пара- графов  5 Стационарное распреде- ление неравновесной концентрации носителей в направлении распро- странения света в по- лупроводнике консультации по слож- ным, непонятным вопро- сам лекций	
рекомбинации носителей заряда и температурная зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников полупроводни полупроводников полупроводников полупроводников полупроводников	
зависимость примесной фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников полупроводнико полупр	
фотопроводимости  4 Обнаружительная способность ИК приемников и их зависимости от параметров полупроводников  5 Стационарное распределение неравновесной концентрации носителей в направлении распространения света в полупроводнике  4 Обнаружительная споработа над конспектом параметоры полупроводнике работа над конспектом параметоры пактия с оборудованием; в направлении распростам консультации по сложеным, непонятным вопростам лекций	
4 Обнаружительная спо- собность ИК приемни- ков и их зависимости от параметров полупро- водников самостоятельное изуче- ние отдельных тем, пара- графов  5 Стационарное распреде- ление неравновесной лекции; лабораторные за- концентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распро- странения света в по- лупроводнике сми декций: пабораторные за- консультации по слож- странения света в по- лупроводнике сам лекций	
собность ИК приемни- ков и их зависимости от нятия с оборудованием, параметров полупро- водников ние отдельных тем, пара- графов  5 Стационарное распреде- ление неравновесной лекции; лабораторные за- концентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распро- странения света в по- лупроводнике сма до конспектом декции; лабораторные за- нятия с оборудованием; консультации по слож- странения света в по- лупроводнике сам лекций	
ков и их зависимости от параметров полупро- водников самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов  5 Стационарное распредерательное работа над конспектом декции; лабораторные законцентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распространения света в подупроводнике сам лекций	ение лабо-
параметров полупро- самостоятельное изуче- водников ние отдельных тем, пара- графов  5 Стационарное распреде- ление неравновесной лекции; лабораторные за- концентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распро- странения света в по- лупроводнике сам лекций	ых работ,
водников ние отдельных тем, параграфов  5 Стационарное распредеработа над конспектом дение неравновесной лекции; лабораторные законцентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распроконсультации по сложестранения света в поным, непонятным вопродиме	
графов  5 Стационарное распредеработа над конспектом выполновательное неравновесной лекции; лабораторные законцентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распроконсультации по сложестранения света в подлупроводнике сам лекций	
5 Стационарное распредеработа над конспектом ление неравновесной лекции; лабораторные законцентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распроконсультации по сложестранения света в подлупроводнике сам лекций	
ление неравновесной лекции; лабораторные за- концентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распро- странения света в по- лупроводнике сам лекций	
концентрации носителей нятия с оборудованием; в направлении распроконсультации по сложстранения света в поным, непонятным вопродите сам лекций	ение лабо-
в направлении распро- странения света в по- лупроводнике сам лекций	ых работ
странения света в по- ным, непонятным вопро- лупроводнике сам лекций	
лупроводнике сам лекций	
6 Спектральная зависи-работа нал конспектом	
	ение лабо-
мость собственной фо- лекции; лабораторные за-	_
	ка рефера-
ние на нее скорости по- написание реферата тов	
верхностной рекомбина-	
ции	

7	Зависимость полной ста-	пабота нап конопактом	выполнение лабо-
/		работа над конспектом лекции; лабораторные за-	раторных работ,
		нятия с оборудованием;	1 1 1
	сти поверхностной ре-		ренции
	комбинации	конференции	репции
8	Квазиуровни Ферми для	работа над конспектом	выполнение лабо-
	свободных и захвачен-	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
	ных на локальные уров-	нятия с оборудованием;	коллоквиум
	ни носителей, демарка-	коллоквиум	
	ционные уровни		
9	Зависимость расположе-	работа над конспектом	выполнение лабо-
	ния квазиуровней Ферми	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
	в запрещенной зоне от	нятия с оборудованием;	проверка рефера-
	параметров уровней,	написание реферата;	та
	температуры и скорости		
	генерации носителей		
10	Влияние оптической пе-	работа над конспектом	выполнение лабо-
	резарядки на подвиж-	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
	ность носителей заряда и	нятия с оборудованием;	доклад на конфе-
	на времена их жизни, на	подготовка доклада к	ренции
	спектральные зависимо-	конференции	
	сти поглощения и фото-		
	проводимости		
11	Суперлинейность и суб-	работа над конспектом	выполнение лабо-
	линейность люкс-	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
		нятия с оборудованием;	тесты
	этих эффектов и их ис-		
	-	ным, непонятным вопро-	
	ления параметров полу-	сам лекций	
	проводников		
12	Фотоэлектромагнитный	работа над конспектом	выполнение лабо-
	эффект как метод опре-	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
	деления параметров по-	нятия с оборудованием;	коллоквиум
	лупроводников	коллоквиум	
13	Особенности фоторазо-	работа над конспектом	выполнение лабо-
	грева в сильно легиро-	лекции; лабораторные за-	раторных работ,
	ванных и компенсиро-	нятия с оборудованием;	экзамен
	ванных полупроводни-	подготовка к экзамену	
	ках		

#### Самостоятельная работа

#### Самостоятельная работа студентов включает следующие компоненты:

<b>№№</b> п/п	Наименование работы	Кол- во часов	Форма контроля
1	Проработка лекционного	33	Экзамен

	материала	(0.9)	
2	Подготовка к лаборатор- ным работам	33 (0.9)	Допуск к каждой ла- бораторной работе и защита отчета.

#### 8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

#### Экзаменационные вопросы по дисциплине «Фотоэлектрические явления в полупроводниках»

- 1. Равновесные и неравновесные носители тока, неравновесная проводимость.
- 2. Время жизни неравновесных носителей.
- 3. Релаксация неравновесной проводимости. Линейная рекомбинация.
- 4. Стационарная фотопроводимость. Методы вычисления фотопроводимости из данных опыта.
- 5. Частотная зависимость фотопроводимости.
- 6. Определение времени жизни методом компенсации сдвига фаз.
- 7. Внутренний фотоэффект.
- 8. Ионизация квантами и частицами больших энергий.
- 9. Рекомбинации через локальные центры.
- 10. Захват локальными центрами носителей тока.
- 11. Полупроводник с одним типом ловушек.
- 12. Схема с одним типом ловушек. Случай малой концентрации.
- 13. Релаксация неравновесной проводимости при малой концентрации ловушек.
- 14. Релаксация неравновесной проводимости при малой большой концентрации ловушек.
- 15. Центры рекомбинации и центры прилипания.
- 16. Демаркационные уровни.
- 17. Влияние уровней прилипания на стационарные характеристики неравновесной проводимости.
- 18. Релаксация при наличии а-центров прилипания.
- 19. Релаксация при наличии β-центров прилипания.
- 20. Влияние уровней прилипания на стационарную фотопроводимость.
- 21. Влияние уровней прилипания на стационарные времена жизни электронов и дырок.
- 22. Влияние сильного заполнения уровней прилипания на начальные стадии нарастания фотопроводимости.
- 23. Рекомбинация через многозарядные центры. О спектре сложных центров.
- 24. Время жизни при рекомбинации через многозарядные центры.
- 25. Излучательная рекомбинация свободных электронов и дырок.
- 26. Индуцированная излучательная рекомбинация.
- 27. Влияние прилипания на излучательную рекомбинацию.
- 28. Ударная рекомбинация.
- 29. Особенности примесной фотопроводимости.
- 30. Примесная фотопроводимость, связанная с одним типом уровней.
- 31. Люкс-амперные характеристики и кривые релаксации примесной фотопроводимости.
- 32. Термооптические переходы. Двойные оптические переходы.
- 33. Индуцированная примесная фотопроводимость.
- 34. Оптическая перезарядка примесных центров и кинетика примесной фотопроводимости.
- 35. Влияние перезарядки на кинетику примесной фотопроводимости.

- 36. Термостимулированная проводимость.
- 37. Время жизни носителей тока в зонах.
- 38. Диффузия и дрейф неравновесных носителей тока (основные уравнения).
- 39. Распределения концентрации, заряда и поля при диффузии в случае низкого уровня возбуждения.
- 40. Длина экранирования Дебая.
- 41. Диффузия и дрейф неосновных носителей тока.
- 42. Метод экспериментального определения длины диффузионного смещения и времени жизни неосновных носителей тока.
- 43. Прямой метод определения подвижности неосновных носителей тока.
- 44. Определение соотношения между подвижностью и коэффициентом диффузии для неравновесных неосновных носителей.
- 45. Компенсационный метод измерения подвижности.
- 46. Механизм действия электронно-дырочного перехода.
- 47. Основное уравнение фотодиода.
- 48. Воль-амперная характеристика электронно-дырочных фотоэлементов.
- 49. Люкс-амперная характеристика электронно-дырочных фотоэлементов.
- 50. Спектральное распределение фоточувствительности.
- 51. Температурная зависимость темнового тока, фототока, фото-ЭДС.

Таблица 7.2. Лабораторные работы или лабораторные практикумы

№ п/п	Наименование	Лабораторная работа или лабораторный практикум	Трудоемкость
	темы дисципли-		(в академиче-
	ны		ских часах)
1	ФОТОПРОВОДИ МОСТЬ	Изучение фотоэлектрических явлений в полупроводниках	2
2		Спектральная характеристика фотопроводимости	2
3		Внешний фотоэффект	1
4		Исследование спектрального распределения фототока в полупроводниках	2
5		Определение времени жизни неравновесных носителей заряда	2
6		Определение диффузионной длины неосновных носителей заряда	1
7		Фотоэлектрический эффект	2
8	ФОТОДИЭЛЕКТР ИЧЕСКИЙ И ДРУГИЕ	Фотоэлектрические преобразователи - Фотодатчики	2
9	ЭФФЕКТЫ	Исследование эффекта оптического (инфракрасного) гашения фототока	1
10		Исследование температурного гашения фотопроводимости	1
11		Исследование селективного фотоэффекта	2

#### 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#### дисциплины

#### Основная литература

- 1. Воробьев Л.Е. и др. Фотоэлектрические явления в полупроводниковых и размерноквантовых структурах. СПб, 2001.
- 2. Электрические и фотоэлектрические явления в гетероструктурах на основе полупроводников АЗВ5 и кремния. Салихов Х.М.С-Петербург, 2010.
- 3. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М.: Физматгиз, 1963. 495 с.
- 4. Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники: учеб. программа дисциплины/сост.: В. А. Юзова, Г. Н. Шелованова. Красноярск: ИПК СФУ, 46 с. (Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники: УМКД № 1524/1092-2008/рук. творч. коллектива Г. Н. Шелованова). 2009.
- 5. Исследование электрофизических свойств фоторезисторов на основе PbS. Комиссаров А.Л. 2011.
- 6. Фотоэлектрические явления и эффект поля в квантово-размерных гетеронаноструктурных In(Ga)As/GaAs.Истомин Л.А. 2010.

#### Дополнительная литература

- 1. СТО 4.2-07—2008. Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности / разраб. : Т. В. Сильченко, Л. В. Белошапко, В. К. Младенцева, М. И. Губанова. Введ. впервые 09. 12. 2008. Красноярск : ИПК СФУ, 2008. 47 с.
- 2. Каталог лицензионных программных продуктов, используемых в СФУ / сост.: А. В. Сарафанов, М. М. Торопов. Красноярск: ИПК СФУ, (Вып. 3) 2008.
- 3. Шелованова, Г. Н. Современные проблемы электроники: кремниевая электроника: учеб. пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 178 с.
- 4. Несмелов Н. С., Широков А. А. Сборник задач по курсу "Физические основы микроэлектроники": Учебное пособие для вузов.- Изд. ТУСУР, 2008. – 41 с.
- 5. Методические указания по выполнению конкретных лабораторных работ по курсу ФОМ (имеются в библиотеке ТУСУР и в учебной лаборатории по микроэлектронике кафедры КУДР)// Изд. ТУСУР, 2007. 135 с.

#### Периодическая литературастия вузов. Электроника.

- 6. Известия вузов. Электроника.
- 7. Микроэлектроника.
- 8. Физика и техника полупроводников.
- 9. Нанотехнологии и наноматериалы.
- 10. Нано- и микросистемная техника.
- 11. Перспективные материалы. Микроэлектроника.

#### Информационные ресурсы

12. Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники. Версия 1,0 [Электронный ресурс]: электр. учеб.-метод. комплекс/Г. Н. Шелованова, В. А. Юзова, В. А. Барашков, О. В. Семенова – Электронные дан. (127 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, – (Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники: УМКД № 1524/1092-2008/рук. творч. коллектива Г. Н. Шелованова). 1 электронный оптический

- диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 187 Мб свободного дискового пространства; при-вод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP4/XP SP2 /Vista (32); Adobe Reader 7,0 (или аналогичный продукт для чтения файлов pdf. 2009.
- 13. Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники. Версия 1,0 [Электронный ресурс]: учеб. программа дисциплины/сост.: В. А. Юзова, Г. Н. Шелованова. Электронные дан. (2 Мб). Красноярск:ИПК СФУ, (Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники: УМКД № 1524/1092-2008/рук. творч. коллектива Г. Н. Шелованова). 1 электронный оптический диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1ГГц; 512 Мбоперативной памяти; 50 Мб свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP4/XP SP2 /Vista (32); Adobe Reader 7,0 (или аналогичный продукт для чтения файлов pdf. 2009.
- 14. Шелованова Г. Н. Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники. Версия 1,0 [Электронный ресурс]: электр. курс лекций / Г. Н. Шелованова. Электронные дан. (6 Мб). Красноярск: ИПК СФУ,— (Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники: УМКД № 1524/1092-2008/рук. творч. коллектива Г. Н. Шелованова). 1 электронный оптический диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 50 Мб свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP4/XP SP2 /Vista (32); Adobe Reader 7,0 (или аналогичный продукт для чтения файлов pdf. 2009.
- 15. Унифицированная система компьютерной проверки знаний тестированием UniTest версии 3.0.0. руководство пользователя/А. Н. Шниперов, Б. М. Бидус. Красноярск, 2008.
- 16. Шелованова, Г. Н. Современные проблемы электроники: кремниевая электроника [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие/Г. Н. Шелованова. Электрон. дан. Красноярск: КГТУ, 2006. Режим доступа: http://lib.krgtu.ru/pocobia.phpsection=shelovanova Загл. с экрана.
  - 17. http://www.superconductors.org/
  - 18. http://www. nanoink. net
  - 19. http://www.ioffe.ru/journals/
  - 20. http://journal.sfu-kras.ru/
  - 21. http://www.mikrosystems.ru

#### Программное обеспечение (лицензионное)

Программное обеспечение выбрано в соответствии с каталогом лицензионных программных продуктов, используемых в Сибирском федеральном университете.

- 1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional.
- 2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003 Professional.
- 3. Программный продукт «Антивирус Касперского».
- 4. Программный продукт FineReader 7.0 Professional Edition.
- 5. Программный продукт MATLAB 6.

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Таблица 10.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Название отдель-	Перечень приме-	Цель применения	Пере-
ной темы дисципли-	няемой ИТ или ее		чень компе-
ны (практического	частей		тенций
занятия или лабора-			
торной работы), в ко-			
торой используется			
ТИ			
Исследования оп-	Автоматизиро-	изучение процес-	ПК-1,
тических свойств ма-	ванный лаборатор-	сов, протекающих в	ПК-4
териалов электронной	ный стенд	проводниках в элек-	
техники и параметров		трическом поле;	
оптоэлектронных		<ul> <li>исследование</li> </ul>	
приборов		основных свойств	
		проводников по	
		температурным	
		зависимостям	
		проводимости.	

#### 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.Презентации лекций
- 2. Демонстрации и фрагменты кинофильмов, анимации физических процессов:
- 3.  $\Phi \Pi \ni -02 модуль$
- 2. МТ мультиметр
- 3. РО Осциллограф
- 4. ФПЭ-04 модуль
- 5. ФПЭ-ИП источник питания
- 6. ФПЭ-05 модуль
- 7. PQ генератор звуковой частоты
- 8. ФПЭ-06 модуль
- 9.  $\Phi\Pi\Theta 07 модуль$
- 10. ФПЭ-08- модуль
- 11. ФПЭ МЕ магазин емкостей
- 12. ФПЭ МС магазин сопротивлений
- 13.  $\Phi\Pi\Theta 09 модуль$
- 14. ФПЭ-10 модуль
- 15.  $\Phi\Pi$ Э 11 модуль
- 16. ФПЭ-12 модуль
- 17. ФПЭ 13 модуль
- 18. ФПЭ-20

изменений	:
	изменений

Внесены	изменения	В	части	пунктов
Протокол заседан	ия кафедры №от ‹	«»	20 г.	
Заведующий кафо	•			
(подпись)	(Ф. И. О.)			
	одобрены	dorav	-методическим пьтета.	советом
(к которому отн	осится кафедра-соста	витель)		
Протокол заседан	ия №от «»_		20 г.	
Председатель уче	ебно-методического сог /	вета		
(подпись)	(Ф. И. О.)			
	одобрены		факультет	советом
(к которому отн	осится данное направл	ение подготові	ки/специальность)	
Председатель уче	ебно-методического сог /	вета		
(подпись)	(Ф. И. О.)			
Изменения одобр	ены Учебно-методичес	ским советом у	ниверситета	
протокол №	OT «»	201	г.	
Председатель Уч	ебно-методического со	вета университ	тета//////	ФИО)